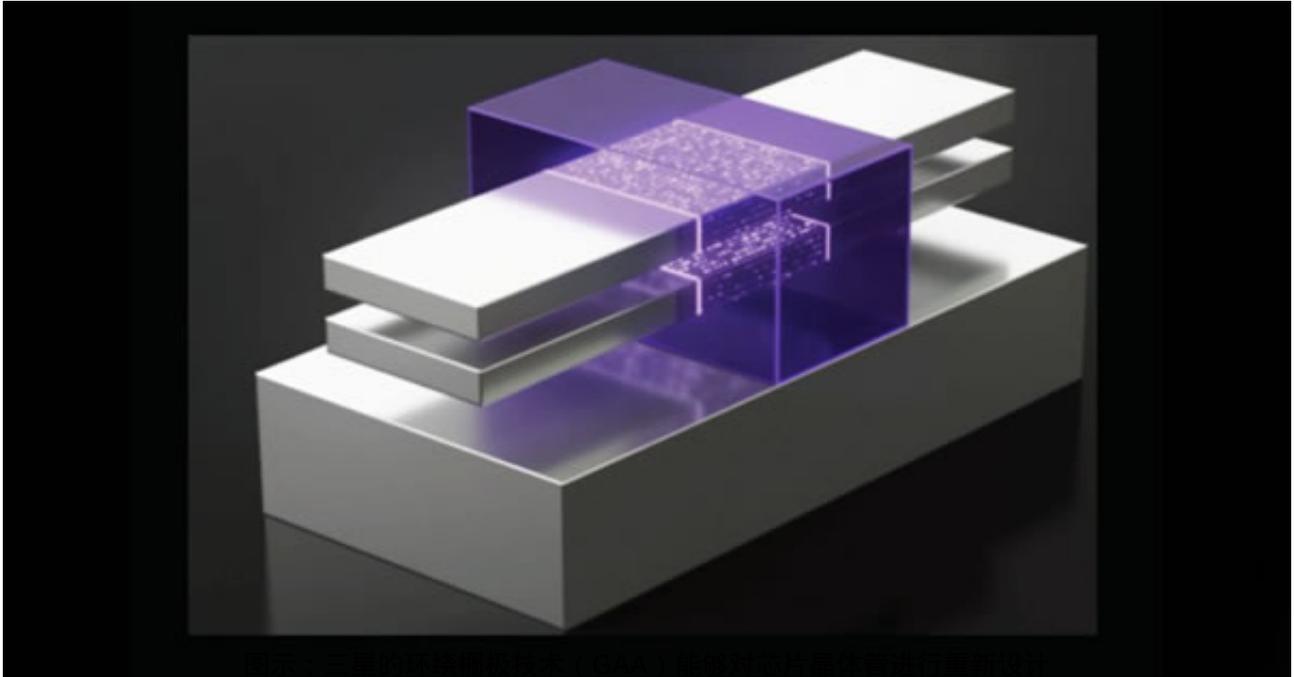


三星2021年将推芯片新技术 性能提高35%能耗降50%

三星将于2021年向市场推出一项突破性的处理器技术，对最基本的电子元件进行根本性改造，使芯片性能提高35%，同时使能耗降低50%。据悉，当地时间周二三星在于加州圣克拉拉举行的三星铸造论坛(Samsung Foundry Forum)上宣布，这项名为“环绕栅极”(gate all around, GAA)的技术能够对芯片核心晶体管进行重新设计和改造，使其更小更快。



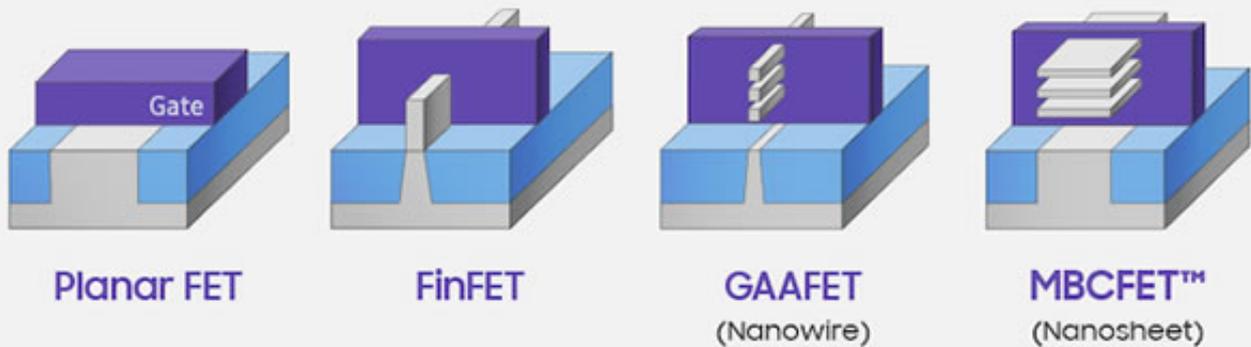
到2021年，应用这种技术的芯片问世后将成为三星与英特尔和台积电等竞争对手的交手中迈出的重要一步。三星希望借此加快芯片行业的发展步伐。近年来，芯片行业一直难以克服极端小型化带来的工程挑战。

国际商业战略咨询公司(International Business Strategies)首席执行官汉德尔·琼斯(Handel Jones)表示，三星强大的材料研究项目正在取得成效。

他表示：“三星在GAA方面领先台积电大约一年时间。”“而英特尔可能落后三星两到三年。”

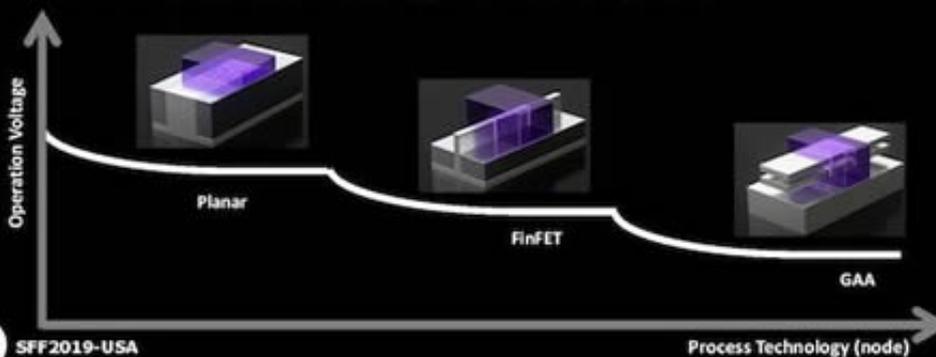
三星的进步将延长摩尔定律所描述的行业进步，确保我们的手机、手表、汽车和家庭互联设备能变得更智能。在GAA技术的帮助下，至少在未来几年，用户可以期待出现更好的图形处理技术、更智能的人工智能和其他计算方面的改进。

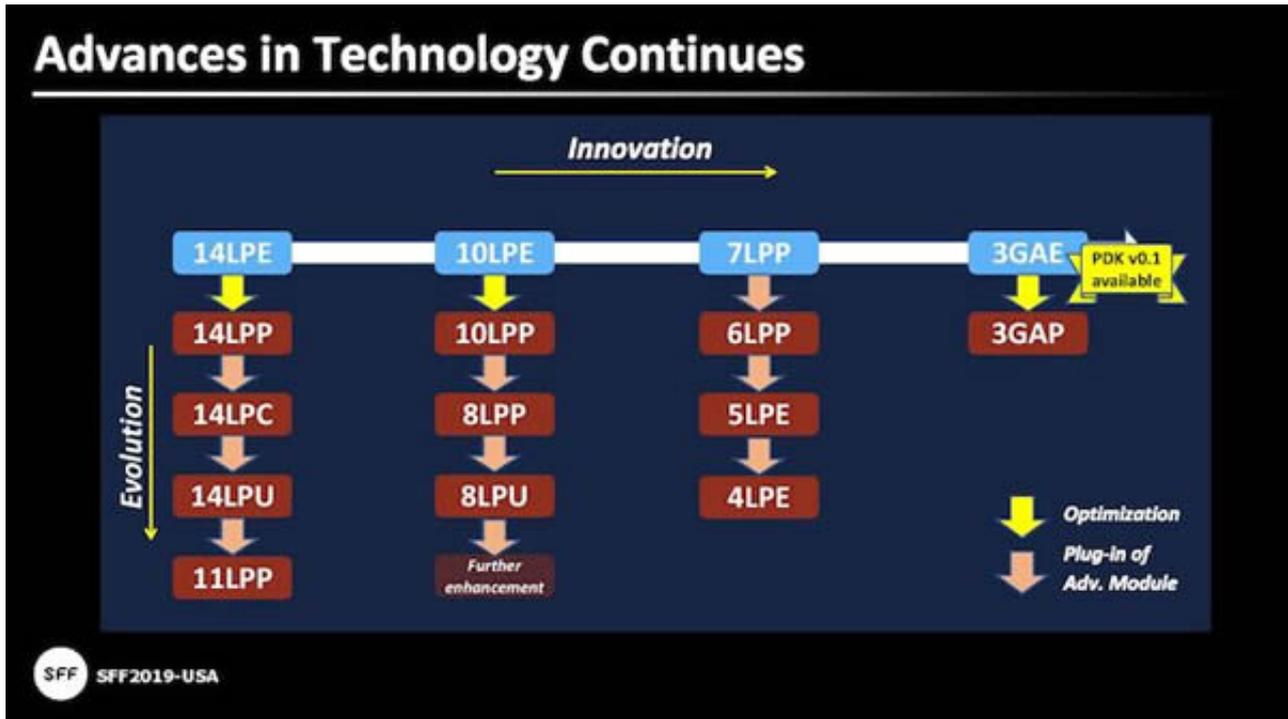
“GAA将标志着我们代工业务进入一个新时代，”三星代工业务营销副总裁瑞安李(Ryan Lee)在本次活动上表示。



GAA(MBCFET™), the Innovation beyond FinFET

- Reduced Operating Voltage (0.75V->0.7V)
- 3nm GAA(3GAE) PDK Version 0.1 is ready
 - Enables early design start for customers
 - Samsung GAA (MBCFET™) uses Nanosheet device (vs. Nanowire)
 - Performance 35% ↑, Power 50% ↓, Area 45% ↓ compared to 7nm





原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/139335.html>